

Номер реєстрації, який є номером свідоцтва	4
Дата реєстрації	15.06.2006
Номер заявки	t 2005 0001
Дата подання заявки	13.09.2005
Дата першого використання топографії ІМС	30.06.2004
Дата, з якої набирають чинності права, що засвідчуються свідоцтвом	15.06.2006
Дата публікації відомостей про реєстрацію топографії ІМС та номер бюлетеня	15.06.2006, Бюл. № 6
Заявник(и)	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал"
Автор(и)	Ткаченко Володимир Олександрович, UA, Філь Віталій Ілларіонович, UA, Шельпук Георгій Данилович, UA, Сапон Сергій Васильович, UA
Власник(и)	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Кристал", Залізничне шосе, 57, м. Київ, 01103
Назва топографії ІМС	ПРЕЦИЗІЙНЕ РЕГУЛЬОВАНЕ ШУНТОВЕ ДЖЕРЕЛО ОПОРНОЇ НАПРУГИ IRU431-Cr
Адреса для листування	ТОВ "НВО "Кристал", Тімонтьєв В. М., п/с 22, м. Київ, 04078

Реферат:

Назва ІМС - Прецизійне регульоване шунтове джерело опорної напруги IRU431-Cr.

Найменування заявника - Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "КРИСТАЛ".

Галузь застосування – контрольно-вимірювальні прилади, пристрої зарядки акумуляторів мобільної електронної апаратури, блоки живлення радіоелектронної апаратури.

Призначення – джерело опорної напруги. Забезпечує опорну напругу в діапазоні від 2,5 В до 36 В з похибкою менше 0,4 % при вихідному струмі до 100 мА і вхідній напрузі до 42 В.

Вид технології – технологія виготовлення ІМС з біполярними транзисторами, іонізованими резисторами, МОН-конденсаторами, з ізоляцією елементів р-п-переходом.

Ознакою топографії, яка є новизною і є предметом заявки, є оригінальність конструкції елементів схеми електричної ІМС і оригінальність розташування елементів на кристалі ІМС. Оригінальність конструкції елементів і їх розташування на кристалі ІМС забезпечили необхідні електричні параметри ІМС при більшій щільності упаковки кристала, тобто дозволили збільшити число елементів схеми, що розміщуються на одиниці площі кристала. Кінцевим результатом такого підходу є зменшення габаритів кристала. Економічний ефект полягає в збільшенні знімання придатних кристалів з однієї платівки при незмінних витратах робочого часу, енергоресурсів і витратних матеріалів. Все це призводить до зниження собівартості кристала.

Дата й місце першого використання топографії ІМС – 30 червня 2004, Україна.

Основні технічні характеристики кристала:

- діапазон опорних напруг від 2,5 В до 36 В регульований;
- похибка опорної напруги менше 0,4 %;
- максимальний вихідний струм - 100 мА;
- струм живлення у виключеному стані - менше 1,0 мкА.